

T0835NMP

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{T(RMS)}$	8A
V_{DRM}	800V
I_{GT}	35mA

用途

- 交流开关
- 相位控制

APPLICATIONS

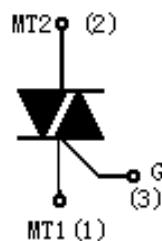
- AC switching
- Phase control

产品特性

- 平面工艺芯片高可靠性和一致性
- 三象限可控硅，触发电流的一致性好
- 环保 RoHS 产品
- The planar process chip for reliability and uniform
- Uniform gate trigger currents in three quadrants
- RoHS products

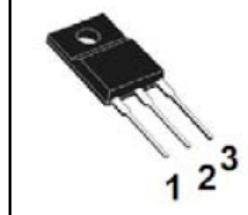
FEATURES

封装 Package



序号 Pin	引线名称 Description
1	主电极 1 MT1
2	主电极 2 MT2
3	门极 G

TO-220MF-K1



订货信息 ORDER MESSAGES

订货型号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管	无卤-条管	有卤-编带	无卤-编带		
Halogen-Tube	halogen-Free-Tube	Halogen-Reel	Halogen-Free-Reel		
T0835NMP-F1-B	N/A	N/A	N/A	T0835NMP	TO-220MF-K1

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^\circ\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	试 验 条 件 Condition	数 值 Value	单 位 Unit
重复峰值断态电压 Repetitive peak off-state voltage	V_{DRM}		± 800	V
通态方均根电流 On-state RMS current	$I_{T(RMS)}$	full sine wave	8	A
非重 复浪涌峰值通态电流 Non-repetitive surge peak on-state current	I_{TSM}	full sine wave, $t=20\text{ms}$	80	A
		full sine wave, $t=16.7\text{ms}$	84	A
	I^2t	$t=10\text{ms}$	36	A^2s
通态电流临界上升率 Repetitive rate of rise of on-state current after triggering	dI/dt	$I_{TM}=12\text{A}, I_G=0.2\text{A}, dI_G/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$	50	$\text{A}/\mu\text{s}$
峰值门极电流 Peak gate current	I_{GM}		4	A
峰值门极电压 Peak gate voltage	V_{GM}		5	V
峰值门极功率 Peak gate power	P_{GM}		5	W
平均门极功率 Average gate power	$P_{G(AV)}$	over any 20ms period	1	W
存储温度 Storage temperature	T_{stg}		-40~150	$^\circ\text{C}$
操作结温 Operation junction temperature	T_{VJ}		-40~150	$^\circ\text{C}$

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC ($T_c=25^\circ\text{C}$)

项目 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Condition		最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
峰值重复断态电流 Peak Repetitive Blocking Current	I_{DRM}	$V_{DM}=V_{DRM}$, $T_j=150^\circ\text{C}$, gate open		-	-	1.0	mA
峰值通态电压 Peak on-state voltage	V_{TM}	$I_{TM}=11.3\text{A}$		-	1.3	1.55	V
门极触发电流 Gate trigger current	I_{GT}	$V_{DM}=12\text{V}$, $R_L=100\Omega$	MT1(-),MT2(+),G(+)	2	-	35	mA
			MT1(-),MT2(+),G(-)	2	-	35	mA
			MT1(+),MT2(-),G(-)	2	-	35	mA
门极触发电压 Gate trigger voltage	V_{GT}	$V_{DM}=12\text{V}$, $R_L=100\Omega$	MT1(-),MT2(+),G(+)	-	0.7	1.0	V
			MT1(-),MT2(+),G(-)	-	0.7	1.5	V
			MT1(+),MT2(-),G(-)	-	0.7	1.5	V
维持电流 Holding current	I_H	$V_{DM}=12\text{V}$, $I_{GT}=0.1\text{A}$		-	-	50	mA
擎住电流 Latching current	I_L	$V_{DM}=12\text{V}$, $I_{GT}=0.1\text{A}$	MT1(-),MT2(+),G(+)	-	-	50	mA
			MT1(-),MT2(+),G(-)	-	-	50	mA
			MT1(+),MT2(-),G(-)	-	-	50	mA
断态临界电压上升率 Rise of off-state voltage	dV/dt	$V_{DM}=67\% V_{DRM(\text{MAX})}$, $T_j=150^\circ\text{C}$, gate open		1000	-	-	V/ μs
门极开通时间 Gate controlled turn-on time	t_{gt}	$I_{TM}=6\text{A}$, $V_{DM}=V_{DRM(\text{MAX})}$, $I_G=0.1\text{A}$, $dI_G/dt=5\text{A}/\mu\text{s}$		-	2	-	μs

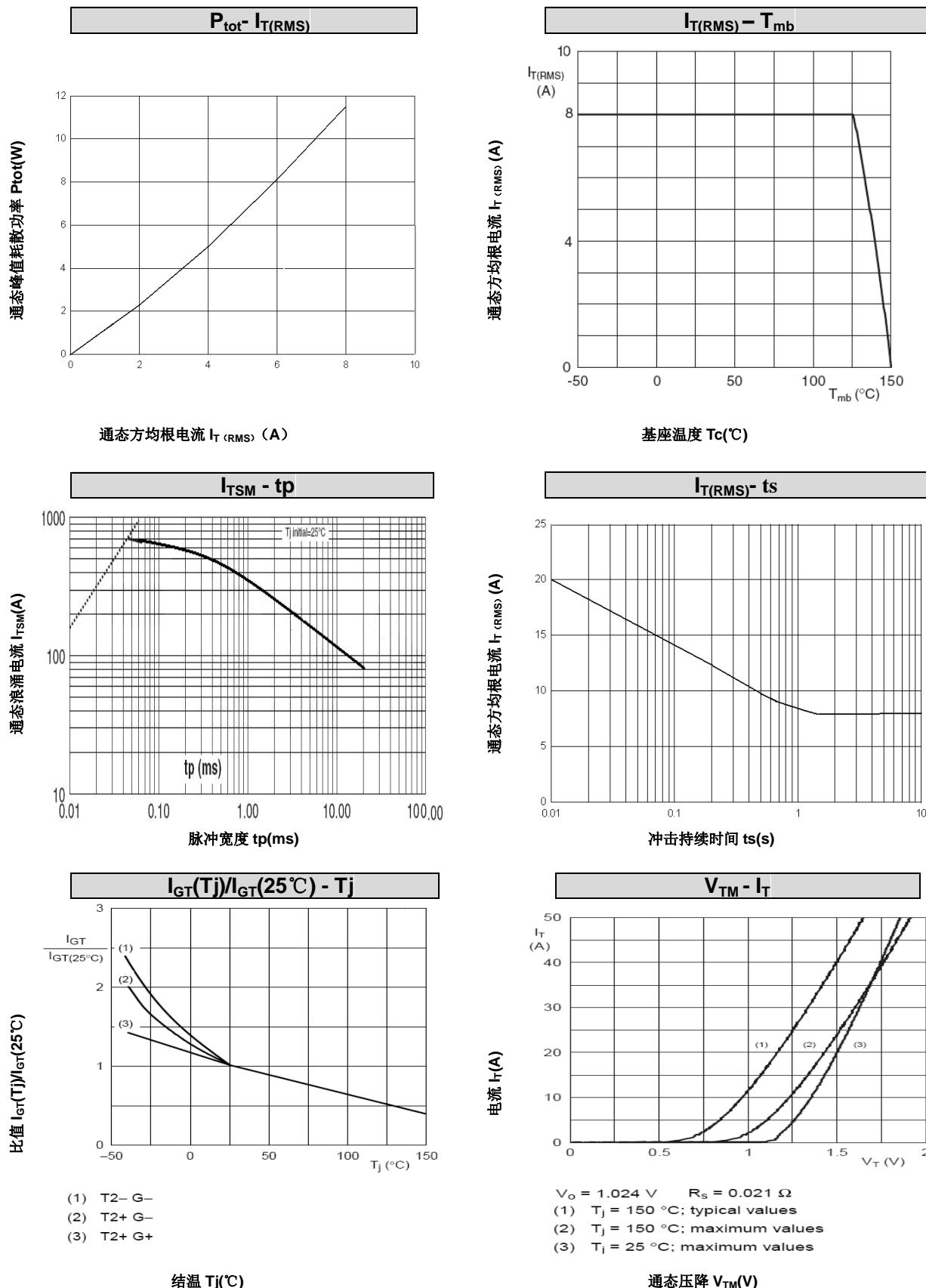
热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项目 Parameter	符号 Symbol	条件 Condition	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
结到安装面的热阻 Thermal resistance junction to mounting base	$R_{th(j-mb)}$	full cycle(TO-220MF-K1)			2.0	°C/W

电绝缘特性 ELECTRICAL ISOLATION

项目 Parameter	符号 Symbol	条件 Condition	数值 Value	单位 Unit
绝缘电压 Isolation voltage	V_{ISOL}	1 minute, leads to mounting tab TO-220MF-K1	2000	V

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220MF-K1

单位 Unit : mm

